STATUS OF THE SPring-8 ACCELERATORS

Accelerator Division, JASRI/SPring-8*A), and RIKEN Harima Institute Research Promotion Division^{B)}

^{A)}1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198

^{B)}1-1-1, Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5148

Abstract

SPring-8 is a third generation light source facility, which consists of 1 GeV linac, 8 GeV booster synchrotron, and 8 GeV storage ring. Here we report the present status of the SPring-8 accelerators, as well as the recent progress of the performance improvement.

SPring-8 加速器の現状

1. 加速器運転状況

1.1 運転統計

2009 年度 SPring-8 加速器運転統計は、表1 に示す通 りである。計画利用時間 4056 時間に対する実績 4014 時間 53 分と利用達成率 99.0 %を遂げている。

表	1:	運転統計
---	----	------

総運転時間	5068 時間 46 分
マシン調整	1019 時間 05 分
内マシンスタディ	253 時間 59 分
BL 及測定系調整	144 時間 00 分
利用運転	4014 時間 53 分
ダウンタイム	34 時間 48 分

過去3年度のダウンタイム内訳を図1に示す。総ダウ ンタイムは若干増加している程度であるが、電磁石(電 源)によるものが大幅に増加している。



1.2 トップアップ運転状況

SPring-8 では平均蓄積電流値の改善、安定化のため、 利用運転中も電子ビームを入射するトップアップ運転を 行っている。トップアップ運転では、入射電流値は 30 µA に絞られ、ビーム寿命によって 20 秒から数分間隔 でビーム入射が行われる。典型的なトップアップ運転状 況を図 2 (左) に示す。

右図は、全利用運時間中の蓄積電流値の分布をプロットしたものである。毎秒データベースに記録している蓄積電流値を 0.01 mA 刻みで分布を見た。蓄積電流値は、

全利用運転時間の 97.3 % で 99.47 mA から 99.52 mA の 間にある。



図 2: 2009 年度利用運転中の蓄積電流値とその分布.

SPring-8 のトップアップ運転では、目標電流値 99.5 mA で、99.4 mA を下回ったら中断したものと定義している。2009 年度は、164 回、計 45 時間 56 分のトップアップ中断があった。中断原因の主なものは、線型加速器モジュレータフォールト(60 回)とブースター RF ダウン(42 回)であった。それぞれ、中断時間に対する割合は、40%と25%であった。これらは高出力の機器であるためフォールトを全くなくすのは困難ではあるが、信頼性を上げ、フォールト率を下げるための改善が続けられている。



図 3: 2009 年度トップアップ中断回数と中断時間内訳.

2. 加速器改善

2.1 線型加速器

2.1.1 電子銃二重化 電子銃がカソード交換を要す るような重篤なトラブルがあった場合、復旧に多大な時 間を要するので、トップアップ運転が長時間中断するだ けではなく、ダウンタイムにも至りかねない。電子銃の 信頼性向上のため、SPring-8 では電子銃の二重化を進め てきた。2007年9月には第2電子銃真空チャンバーが 設置され、2009年9月には第2電子銃用高圧デッキと モジュレータが設置された。この間に、第1電子銃故

^{*} takao@spring8.or.jp

障のため、2008 年 10 月から 12 月までの利用運転で第 1 電子銃用電源による第2電子銃緊急運用があった。各 電子銃の専用電源設置が終わり、現在は加速器安全イン ターロックを含め制御の整備を進めており、本年10月 以降には迅速な切り替えが可能になる。



図 4: 第2電子銃配置.

2.1.2 クライストロンモジュレータ改良 線型加速 器クライストロンモジュレータでも、信頼性向上のため の改良が加えられている。

メンテナンス性向上も考慮し、サイラトロンスタン ド更新が行われ、モジュレータフォールト率の減少に貢 献している。主な改良点は以下の通り。

- スタンド下部アース強化。
- 冷却能力強化のため、スタンド下部にあった冷却 ファンを横付けに変更。
- 分圧回路をサイラトロン本体を囲むチムニー型からサイラトロン側方に配置するオープン型に変更。

また、HV Fanout 回路が温度ドリフトが激しいなど安定でなかったため、特性を揃えるよう回路の改修を行った。この結果、図5に見られるように、PFN 電圧の長期安定度が向上した。図5は、リニアックモジュレータの1台(H0モジュレータ)の設定値に対するモニタ値の比をFanout回路更新前後1年に亘ってプロットしたものである。更新前は長期的な変動が見られるが、更新後は一定になっている。



図 5: Fanout 回路更新前後の PFN 電圧変動.

2.2 ブースターシンクロトロン

2.2.1 RF-KO システム二重化 SPring-8 蓄積リング のシングルバンチ運転では、ブースターシンクロトロ ンに設置された RF-KO 方式によるバンチ純化装置でシ ングルバンチを生成して、蓄積リングへ入射している。 ユーザの要求はバンチ不純度10⁻⁸以下と非常に厳しく、 RF-KOに用いるキッカーアンプの不発があると、不純 度の高いビームが蓄積リングに入射され、蓄積ビーム 廃棄、再入射の必要があり、ダウンタイムに直結する。 これを避けシステムの信頼性を向上するため、2009年 9月に RF-KO システムの二重化がなされた。

RF-KO システム 1,2 の稼働状態とバンチ不純度の関係は、表 2 に示す通りである。どちらか 1 台が稼働していれば、不純度 10⁻⁹ 以下とユーザの要求を満たしている。

表 2: RF-KO システム稼働状態とバンチ不純度.

RF-KO		バンチ不純度				
1	2	主バンチ前方	主バンチ後方			
稼働	稼働	$3.4 imes10^{-10}$ 以下	$8.1 imes 10^{-10}$ 以下			
稼働	停止	$3.5 imes 10^{-10}$ 以下	$5.9 imes 10^{-10}$ 以下			
停止	稼働	$3.6 imes 10^{-10}$ 以下	$8.4 imes 10^{-10}$ 以下			
停止	停止	$9 imes 10^{-8}$ 以下	$7 imes10^{-6}$ 以下			

2.2.2 省エネルギー運転^[1] ブースターシンクロト ロンは、1-8 GeV のエネルギーランプアップを1 Hz で 行い、これに対応して主電磁石はパターン運転をしてい る。SPring-8 トップアップ運転でのビーム入射は、ビー ム寿命に依存して 20 秒から数分に1ショットの頻度で 行われるが、磁場等の安定性を考慮してビーム入射がな い時でもブースター主電磁石はパターン運転を連続し ていた。

そこで、トップアップ運転においてビーム入射がない 時にはパターン運転を停止して、ブースター主電磁石の 消費電力を最大 1/5 にまで削減することができる。この 時に問題となるのが、熱負荷変化に伴う磁場の変動であ る。四極磁場が変化すると、ベータトロンチューンが変 動し、RF-KOの共振から外れ、図6に示すようにバン チ純度の悪化を引き起こす。



図 6: 省エネルギー運転実施後のバンチ純度.

これを解決するため、電磁石系および電磁石電源系の 冷却水温度の精密調整が可能となるよう各冷却設備改 造を実施した。この結果、機器の温度変動が抑えられ、 ベータトロンチューンが安定化して、図7に示されてい る通り、省エネルギー運転実施後の利用運転中に純度の 悪化は全く見られていない。

Mode	Filling Pattern			電流値 / A		Ratio	Attenuation / dB	
	Train		Singlet	Train Singlet			Train	Singlet
	Fill	バンチ数	バンチ数					
Multi-bunch	160 bunch-train \times 12	1920	-	0.05 -		-	0	
203 Bunches	-	-	203	0.50		-	20	
Hybrid	1/7	348	5	0.24	3.0	12.36	20	35
	1 / 14	174	12	0.46	1.6	3.47	20	35
	2 / 29	168	26	0.38	1.4	3.73	20	35
	4 / 58	168	53	0.28	1.0	3.61	20	35

表 3: SPring-8 利用運転に使用されるバンチフィリングモード.



図 7: 省エネルギー運転実施後のバンチ純度.

2.3 蓄積リング

2.3.1 BBF 改良と低クロマティシティ運転 SPring-8 蓄積リングの特徴の一つに、多彩なバンチフィリング パターンがある。時間構造を必要としない実験には、可 能な限り多くのバケットに電子を蓄積しバンチ電流値 を抑えたマルチバンチモードを使用する。時間構造を必 要とする場合は、全周に等間隔でシングルバンチを蓄積 する。特に広い時間間隔を必要とする場合にはバンチ電 流値が大きくなるが、これによるRF コンタクトやセラ ミックチャンバーでの発熱の問題で、シングルバンチ電 流値が制限されている。その場合、蓄積電流値 100 mA を確保するため、一部の間隔を連続的にバンチ(バンチ トレイン)で埋めたハイブリッドモードが使用される。 現在、SPring-8 の利用運転中に使用されるバンチフィリ ングモードを表 3 に示す。

蓄積リングでは、ビーム不安定性を抑制するため bunch-by-bunch feedback (BBF) が導入されている。と ころが、フィリングモード'1/7 fill + 5 single bunches では、表3にある通りトレイン部とシングルバンチ部 電流値の高いコントラストのため、シングルバンチ部 の垂直方向不安定性が十分に抑制できなかった。シング ルバンチ部の信号レベルが高すぎるため飽和してしま い、フィードバックが働かずに不安定性が起こるからで ある。このため、2009 年 12 月までは垂直クロマティシ ティを6と大きな値に設定することで、ランダウ減衰を 利用して不安定性を抑えていた。

この状況を解決するため、バンチ電流値に応じて自動 的に減衰率を変える減衰器の開発を進めてきた^[2]。こ れにより、入力信号の減衰率を表3にある通りトレイン 部とシングルバンチ部で変えられ、飽和の問題を避け ることができる。同時に、BBF キッカーのパワー増強 もなされ、2010年1月より垂直クロマティシティを2 まで下げることができた。この結果、利用運転時の入射 効率が10%程度改善された。図8に垂直クロマティシ ティ変更前後の利用運転サイクル中の入射効率を示す。



図 8: 垂直クロマティシティ変更前後の利用運転サイク ルの入射効率.

2.3.2 ビーム入射時の蓄積ビーム振動抑制

利用実験中もビーム入射を行うトップアップ運転で は、ビーム入射に伴う蓄積ビームの振動を極力抑えなけ ればいけない。このため、SPring-8 では入射時蓄積ビー ム振動抑制の努力を続けてきた。入射時蓄積ビーム振動 の主な原因は、入射バンプ軌道内にある六極電磁石の 非線形磁場によるキック^[3]とバンプ軌道を形成する4 台のバンプ電磁石の磁場波形の非相似性^[4]である。前 者については、六極電磁石非線形磁場が相殺するラティ スを開発することでほぼ解決した。

バンプ電磁石磁場波形の非相似性は、外側2台と内 側2台の形状が異なるため、キック量に差があることに 起因する。バンプ電磁石磁場波形の始点付近では、キッ ク量の違いから電源の立ち上がり特性がずれるため相 似性が崩れ、その残差によって蓄積ビームが蹴られる。 一方、終点近傍では、バンプ電磁石の金属端板を流れる 渦電流の影響によって蓄積ビーム振動が引き起こされ ていた。バンプ電磁石形状によってバンプ電磁石磁場と 渦電流による磁場の比率が異なり、磁場波形の相似性が 乱れていた。これによる蓄積ビーム振動の振幅は2mm にも達するものであったが、渦電流が流れないよう非金 属端板を持ったバンプ電磁石に更新することでほぼ解消 した。

立ち上がりの入射時蓄積ビーム振動の抑制に関して は、補正用高速キッカーの開発が進められている^[6]。図 9の赤線は、バンプ電磁石励磁後の蓄積ビーム振動を turn-by-turn BPM で測定したものである。ビーム周回時 間は 4.8 µs、バンプ電磁石パルス幅 8 µs、x 軸の原点が



図 9: 高速キッカーによる蓄積ビーム振動の抑制.

バンプ電磁石立ち上がりに対応する。蓄積ビームは、立 ち上がりで蹴られるため周回毎に振幅がピーク状に大 きくなっている。これをキャンセルするための高速キッ カーが開発され、2010年10月以降の利用運転で本格運 用される予定である。図10は、高速キッカーパルス幅 に対する蓄積ビーム振動抑制効果を見たものである。図 9の青線は、補正後の蓄積ビーム振動を表す。高速キッ カー設置場所のベータトロン位相の関係から、バンプ電 磁石励磁後3ターン目に高速キッカーは励磁され、それ 以降の蓄積ビーム振動が抑えられている。



図 10: 高速キッカーによる蓄積ビーム振動の抑制.

また、バンプ電磁石は水平方向に蓄積ビームをキック するものであるが、回転エラーのため垂直方向にもキッ クすることになる。これを効率よく補正するため、遠隔 バンプ電磁石 tilt 制御システムを開発した^[5]。現在、更 なる抑制を目指して調整手法の改良が進んでいる。元々、 振動を測るモニタとして turn-by-turn BPM を用いてい たが、S/N の関係で抑制性能が制限されていた。モニタ として可視光干渉計ビームサイズモニタを用いること で、抑制性能が改善することができた。現在、更なる向 上を目指して、感度の良い BBF のビーム位置モニタを 用いたバンプ電磁石 tilt 調整法を開発している。

参考文献

- [1] T. Aoki, et al., 本年会報告集, THPS120.
- [2] K. Kobayashi, and T. Nakamura, Proc. of ICALEPCS2009 (2009), 659.
- [3] H. Tanaka, et al., Proc. of EPAC04 (2004), 1330; H. Tanaka, et al., Nucl. Instrum. Method A 539 (2005), 547.
- [4] T. Ohshima, et al., Proc. of EPAC04 (2004), 1330.
- [5] K. Fukami, et al., Proc. of EPAC08 (2008), 2172.
- [6] S. Mitsuda, et al., 本年会報告集, WEPS036.